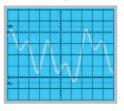


15 MHz Arbitrary Funktionsgenerator HM8131-2



NF-Arbitrarysignal



Option H086 Hochstabiler TCXO



Option H0831 SRAM Memory Card 1MB



Frequenzbereich 100 µHz – 15 MHz

DDS-Signalgenerator (Frequenzstabilität 10 ppm)

6 Standard-Signalformen und Arbitrary

Master-Slave Betrieb für bis zu 3 Generatoren

SRAM Memory Card zur Signalspeicherung (Option H0831)

Erhöhte Frequenzstabilität mit TCXO (Option H086): ± 5 x 10⁻⁷ bei 23° C (24 Std.)







15 MHz Arbitrary Funktionsgenerator HM8131-2 bei 23 °C nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten

Frequenzspezifikationen		
Bereich:	100 μHz bis 15 MHz	
Auflösung:	100 μHz; 100 mHz (Wobbelbetrieb)	
Anzeige:	<10 ms (ohne Bandwechsel) <60 ms (mit Bandwechsel)	
Genauigkeit:	Standardoszillator: ±(10 ppm x Freq.+ 30 µHz) TCXO (Option H086): ±(0,5 ppm x Freq.+ 30 µHz) HM8125 (ext. Referenzfrequenz): ±30 µHz	
Temperaturkoeff.:	Standardoszillator: 2ppm/°C TCXO (Option H086): 0,5 ppm/Jahr	
Alterung:	Standardoszillator: 10 ppm/Jahr TCXO (Option H086): 2 ppm/Jahr	

Signalformen		
Sinus		
Frequenzbereich:	100 µHz bis 15 MHz	
Amplitude:	0-20 V _{ss} (Leerlauf)	
Klirrfaktor:	10 Hz bis 20 kHz:	< 0,1%
	20 kHz-3 MHz:	< 1%
	3 MHz-15 MHz:	< 3%
Nichtharmonische		
Verzerrung:	100 μHz-1 MHz: <-65 d	Bc
	1 MHz-15 MHz: <-(65	dBc + 6 dBc/Octave
Phasenrauschen:	<-90 dBc/√Hz (0 dBm, 1	kHz v. Träger)

Rechteck	
Frequenzbereich:	100 μHz bis 15 MHz
Amplitude:	0-20 V _{ss} (Leerlauf)
Anstiegs-/Abfallzeit:	<10 ns
Überschwingen:	<5% (U _{Aus} ≤200 mV)
Symmetrie:	50 % ±(5 %+10 ns)
Sägezahn	
Frequenzbereich:	100 μHz bis 100 kHz
Amplitude:	0-20V _{ss} (Leerlauf)
Linearität:	besser als 1 % (< 100 kHz)
Polarität:	positiv/negativ
Anstiegs/Abfallzeit:	45 ns
Dreieck	
Frequenzbereich:	100 μHz bis 1 MHz
Amplitude:	0 - 20 V _{ss} (Leerlauf)
Linearität:	besser als 1% (< 100 kHz)
Rauschen	
Weißes Rauschen:	Bandbreite 10 MHz
Rosa Rauschen:	Bandbreite 100 kHz
Arbitrary	
Frequenzbereich:	100 μHz bis 10 MHz
Amplitude:	max. 20 V _{ss} (Leerlauf)
Ausgaberate:	40 MSa/s
Auflösung:	12 bit (Amplitude)
Filter:	Bessel, 7. Ord. b=10 MHz
Speicher:	1x 4 K-Worte nicht flüchtig
	1x 16 K-Worte flüchtig
Jitter:	< 25 ns
Eingänge	
Gate/Trigger	
Impedanz:	$5 \mathrm{k}\Omega\mathrm{II}100\mathrm{pF}$ (geschützt bis $30\mathrm{V}$)

Linearität:	besser als 1 % (< 100 kHz)		
Polarität:	positiv/negativ		
Anstiegs / Abfallzeit:	45 ns		
Dreieck			
Frequenzbereich:	100 μHz bis 1 MHz		
Amplitude:	0 - 20 V _{ss} (Leerlauf)		
Linearität:	besser als 1% (< 100 kHz)		
Rauschen			
Weißes Rauschen:	Bandbreite 10 MHz		
Rosa Rauschen:	Bandbreite 100 kHz		
Arbitrary			
Frequenzbereich:	100 µHz bis 10 MHz		
Amplitude:	max. 20 V _{ss} (Leerlauf)		
Ausgaberate:	40 MSa/s		
Auflösung:	12 bit (Amplitude)		
Filter:	Bessel, 7. Ord. b=10 MHz		
Speicher:	1x 4 K-Worte nicht flüchtig		
	1x 16 K-Worte flüchtig		
Jitter:	< 25 ns		
Eingänge			
Gate/Trigger			
Gate/Trigger Impedanz:	5 kΩ II 100 pF (geschützt bis 30 V)		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation	, j		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz:	5 kΩ II 100 pF (geschützt bis 30 V) 1 kΩ (geschützt bis ±30 V)		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz	1 kΩ (geschützt bis ±30 V)		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz:	1 kΩ (geschützt bis ±30 V) 10 MHz ± 2 ppm		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung:	1 kΩ (geschützt bis ±30 V) 10 MHz ± 2 ppm 1 V _{eff}		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz:	1 kΩ (geschützt bis ±30 V) 10 MHz ± 2 ppm		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz:	1 kΩ (geschützt bis ±30 V) 10 MHz ± 2 ppm 1 V _{eff}		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz: Ausgänge	1 kΩ (geschützt bis ±30 V) 10 MHz ± 2 ppm 1 V_{eff} 500 Ω (geschützt bis ±30 V)		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz:	$1 k\Omega$ (geschützt bis ±30 V) $10 \text{MHz} \pm 2 \text{ppm}$ 1V_{eff} 500Ω (geschützt bis ±30 V) BNC-Buchse; kurzschlussfest		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz: Ausgänge	1 kΩ (geschützt bis ±30 V) 10 MHz ± 2 ppm 1 V _{eff} 500 Ω (geschützt bis ±30 V) BNC-Buchse; kurzschlussfest Fremdspg. max. ±15 V f. 30 s.		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz: Ausgänge	1 kΩ (geschützt bis ± 30 V) 10 MHz ± 2 ppm 1 V _{eff} 500 Ω (geschützt bis ± 30 V) BNC-Buchse; kurzschlussfest Fremdspg. max. ± 15 V f. 30 s. 50 Ω		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz: Ausgänge Signalausgang:	$1 k\Omega$ (geschützt bis ±30 V) $10 \text{MHz} \pm 2 \text{ppm}$ 1V_{eff} $500 \Omega \text{(geschützt bis ±30 V)}$ BNC-Buchse; kurzschlussfest Fremdspg. max. ±15 V f. 30 s. 50Ω Bereich 1: 2,1 - 20 V_{SS} (Leerlauf)		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz: Ausgänge Signalausgang: Impedanz:	$1 k\Omega \left(\text{geschützt bis } \pm 30 \text{V} \right)$ $10 \text{MHz} \pm 2 \text{ppm}$ 1V_{eff} $500 \Omega \left(\text{geschützt bis } \pm 30 \text{V} \right)$ $BNC-Buchse; kurzschlussfest$ $Fremdspg. max. \pm 15 \text{V} f. 30 s.$ 50Ω $Bereich 1: \qquad 2,1 - 20 \text{V}_{\text{SS}} \text{[Leerlauf]}$ $Bereich 2: \qquad 0,21 - 2,0 \text{V}_{\text{SS}} \text{[Leerlauf]}$		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz: Ausgänge Signalausgang: Impedanz: Ausgangsspannung:	$1 \text{k}\Omega \left(\text{geschützt bis } \pm 30 \text{V} \right)$ $10 \text{MHz} \pm 2 \text{ppm}$ 1V_{eff} $500 \Omega \left(\text{geschützt bis } \pm 30 \text{V} \right)$ $BNC-Buchse; \text{kurzschlussfest}$ $Fremdspg. \text{max.} \pm 15 \text{V} \text{f.} 30 \text{s.}$ 50Ω $Bereich 1: \qquad 2,1 - 20 \text{V}_{\text{SS}} \text{[Leerlauf]}$ $Bereich 2: \qquad 0,21 - 2,0 \text{V}_{\text{SS}} \text{[Leerlauf]}$ $Bereich 3: \qquad 20 - 200 \text{mV}_{\text{SS}} \text{[Leerlauf]}$		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz: Ausgänge Signalausgang: Impedanz:	$1 k\Omega \left(\text{geschützt bis } \pm 30 \text{V} \right)$ $10 \text{MHz} \pm 2 \text{ppm}$ 1V_{eff} $500 \Omega \left(\text{geschützt bis } \pm 30 \text{V} \right)$ $BNC-Buchse; kurzschlussfest$ $Fremdspg. max. \pm 15 \text{V} \text{f}. 30 \text{s}.$ 50Ω $Bereich 1: 2,1 - 20 \text{V}_{\text{ss}} \text{[Leerlauf]}$ $Bereich 2: 0,21 - 2,0 \text{V}_{\text{ss}} \text{[Leerlauf]}$ $Bereich 3: 20 - 200 \text{mV}_{\text{ss}} \text{[Leerlauf]}$ $3 \text{W} \text{digit} \left(100 / 10 / 1 \text{mV} \right)$		
Gate/Trigger Impedanz: Amplitudenmodulation Impedanz: Externe Referenz Frequenz: Eingangsspannung: Impedanz: Ausgänge Signalausgang: Impedanz: Ausgangsspannung:	$1 \text{k}\Omega \left(\text{geschützt bis } \pm 30 \text{V} \right)$ $10 \text{MHz} \pm 2 \text{ppm}$ 1V_{eff} $500 \Omega \left(\text{geschützt bis } \pm 30 \text{V} \right)$ $BNC-Buchse; \text{kurzschlussfest}$ $Fremdspg. \text{max.} \pm 15 \text{V} \text{f.} 30 \text{s.}$ 50Ω $Bereich 1: \qquad 2,1 - 20 \text{V}_{\text{SS}} \text{[Leerlauf]}$ $Bereich 2: \qquad 0,21 - 2,0 \text{V}_{\text{SS}} \text{[Leerlauf]}$ $Bereich 3: \qquad 20 - 200 \text{mV}_{\text{SS}} \text{[Leerlauf]}$		

(außer Arbitrary)

Einstellgenauigkeit:	Sinus 1 kHz: Rechteck 1 kHz:	$\pm (1\% \text{ x Amplitude} + 5 \text{ digit})$ $\pm (3\% \text{ x Amplitude} + 5 \text{ digit})$
Frequenzgang:	<100 kHz: 100 kHz - 1 MHz	
	1 MHz - 15 MHz:	+0,5 dB
Temperaturstabilität: Trigger-Ausgang	±0,1%/°C BNC-Buchse, ku	urzschlussfest
Pegel: Sägezahnausgang	5V/TTL	
Spannungsverlauf:	0-5V; synchron	zum Sween
Impedanz:	1 kΩ	zum Sweep
DC-Offset	D : 1 4	5)/ 5)/(1 6)
Ausgangsspannung:	Bereich 1: Bereich 2: Bereich 3:	-5 V +5 V (Leerlauf) -0,5 V +0,5 V (Leerlauf) -50 mV +50 mV (Leerlauf)
Auflösung:	3 digit	
Genauigkeit:	±(1% x Offsetsp	g. + 5 digit)
Temperaturstabilität:	±0,1%/°C	
Phase		
Bereich:	0 - 359,9°	
Auflösung:	0,1°	
Bezug:	abfallende Flank	ke des SyncSignals
Jitter:	<25 ns	
Genauigkeit:	außer Rechteck:	: ± (0.1+ Freq./ Hz x 10 ⁻⁶)
		Grad
	Rechteck:	± (5 + Freq./Hz x 30 x 10 ⁻⁶) Grad
		Orau
Sweep (intern)		
Interne Wobbelung:		en linear oder log.
Bereiche:		x. Signalfrequenz
W 11 1 1		gs- und Endfrequenz
Wobbelzeit:		s kontinuierlich oder getrig-
Modulation	gert (ext. Signat,r	Frontplattentastatur, Interface)
FSK / PSK:	alle Signale	
Frequenzbereich:	100 µHz bis max	Frequenz
Triggerung:	durch externes	
Mindestdauer:	25 µs	
Verzögerung:	PSK:	typ.10 µs
Amulitudonmodulation	FSK:	typ.15μs
Amplitudenmodulation Modulationsquelle:	intern oder exter	rn
Modulationsgrad:	0 bis 100 %	
Bandbreite:	DC - 20 kHz (-3 d	dB)
Trägerfreguenz:		. Signalfrequenz
Genauigkeit:	± (5 % der Anzeig	
o chadightert.	_ (0 /0 001 / 1112010	
Interne Modulation:	1 kHz Sinus	
_	1 kHz Sinus 20 Hz – 20 kHz	
Interne Modulation: Externe Modulation: Gate:	1 kHz Sinus 20 Hz – 20 kHz (asynchron)	
Interne Modulation: Externe Modulation: Gate: Verzögerungszeit:	1 kHz Sinus 20 Hz – 20 kHz (asynchron) <150 ns	
Interne Modulation: Externe Modulation: Gate: Verzögerungszeit: Eingangssignal:	1 kHz Sinus 20 Hz - 20 kHz (asynchron) <150 ns TTL	
Interne Modulation: Externe Modulation: Gate: Verzögerungszeit: Eingangssignal: Triggerfunktion:	1 kHz Sinus 20 Hz - 20 kHz (asynchron) <150 ns TTL (synchron)	
Interne Modulation: Externe Modulation: Gate: Verzögerungszeit: Eingangssignal: Triggerfunktion: Frequenzbereich:	1 kHz Sinus 20 Hz - 20 kHz (asynchron) <150 ns TTL (synchron) <500 kHz	
Interne Modulation: Externe Modulation: Gate: Verzögerungszeit: Eingangssignal: Triggerfunktion:	1 kHz Sinus 20 Hz - 20 kHz (asynchron) <150 ns TTL (synchron) <500 kHz	

Verschiedenes	
Opt. Memory-Card:	PCMCIA II-Format bis 1 MB
	zur Speicherung von bis zu 16 ARB-Signalen
Speicher:	10 für Geräteeinstellung;
	1 f. Speicherung von ARB-Signalen
RS-232:	Schnittstelle eingebaut
Schutzart:	Schutzklasse I (EN 61010-1)
Netzanschluss:	115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 30 VA
Betriebsbedingungen:	+10 °C bis +40 °C
Max. rel. Luftfeuchtigkeit:	10 %-90 % (ohne Kondensation)
Gehäuse (B x H x T):	285 x 75 x 365 mm
Gewicht:	ca. 5 kg

Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, Bedienungsanleitung Optionales Zubehör: HZ33/HZ34 50 Ω Messkabel BNC-BNC, H0831 Memory

Card 1 MB, HZ10 Silikonumhüllte Messleitung, HZ20 Adapterstecker